

半導體設備產品比較表

Product model		VF-5900	VF-5700	VF-5300	VF-5100	VF-3000	VF-1000	Model 200	Model 206A	S02-12-F	S02-12L-F	S02-30L-F	S02-60-F	VFS-4000	RLA-1200	RLA-3100	RLA-3100-V	RLA-4106-V	RLA-4200-V	VF-5300HLP	VF-5300H	VF-3000HLP	VF-3000H	CLH
晶圓尺寸	φ300mm	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	φ200mm	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	最大φ150mm	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	*1	○	○	○	○	○
	600×600mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	510×515mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300×300mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○
批量大小 [最大存放數 / 系統]	φ300mm	100	50	-	-	-	25	-	-	100 *2	104 *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	φ200mm	-	-	150	150	50	25	125	-	100 *2	-	-	-	-	1	1	1	1	2	100	75	-	50	200
	最大φ150mm	-	-	200	150	75	50	150	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	100	100	50	75	200
	600×600mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 *2	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	510×515mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 *2	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300×300mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 *2	-	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他 (矩形基板等)	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
*1 需協商 *2 基板厚度與翹曲的影響、處理片數會有增減的情況。																								
傳輸系統	晶圓 (基板)	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	盒式堆料器	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
	FOUP開口器	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOUP儲料器	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SMIF Pod開口器	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
系統	直立式爐管	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
	橫型爐管	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	燈退火系統	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	潔淨烤箱系統	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	大口徑直立式爐管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SiC功率半導體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
半導體	退火	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-
	熱氧化	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
	LPCVD (SiN, Poly-Si (Non-Doped, P-Doped) TEOS, HTO)	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	活化退火	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
	雜質擴散	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	聚酰亞胺固化	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	吸雜	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	燒結/合金	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SiC功率半導體	活化退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	熱氧化	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	氮化/氧氮化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	LPCVD (TEOS)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POA	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	接觸退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
MEMS	熱氧化	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LPCVD	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VCSEL	熱氧化	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	接觸退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	退火	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV (光電)	雜質擴散	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	熱氧化	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
包裝	聚酰亞胺固化	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	烘烤	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
FPD	固化 (聚酰亞胺固化)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	活化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	脫氫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	熔塊燒製	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	金屬接觸退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-